

ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ЭПР КРИСТАЛЛОВ $\text{CdI}_2\text{-Eu}$ И $\text{CdBr}_2\text{-Eu}$

Г. Е. Архангельский, И. М. Болеста, Х. У. Мартинес,
М. В. Фок

УДК 535.343.2; 535.373.1; 538.6

Показано, что в спектре поглощения и люминесценции кристаллов $\text{CdI}_2\text{-Eu}$ и $\text{CdBr}_2\text{-Eu}$ ряд полос обусловлен центрами Eu^{2+} . В $\text{CdI}_2\text{-Eu}$ примесные ионы занимают несколько неэквивалентных позиций, связанных с ошибками наложения атомных слоев решетки.

Как было показано в /1,2/, ошибки наложения атомных слоев решетки сульфида цинка с некоторыми примесями проявляются в спектрах ЭПР, оптического поглощения, люминесценции и ее поляризации. Чтобы выяснить, связано ли это с особенностью решетки ZnS , или имеет более общий характер, были исследованы кристаллы $\text{CdI}_2\text{-Eu}$, решетка которых, как известно, также склонна к образованию политипов, но существенно отличается по своему строению от ZnS . Результаты сопоставлялись с известными данными /3/ для кристаллов $\text{CdBr}_2\text{-Eu}$, аналогичных по структуре $\text{CdI}_2\text{-Eu}$, но практически не имеющих политипов.

И те, и другие кристаллы, активированные европием, выращивались методом Бриджмена-Стокбаргера из соли, предварительно очищенной комплексом физико-химических методов. При этом в зоне кристаллизации создавался высокий градиент температуры, чтобы предотвратить выпадение примеси в виде осадка вследствие значительного различия температур плавления активатора и основания. Кристаллы CdI_2 и CdBr_2 активировались соответственно EuI_3 и EuBr_3 , которые вводились в шихту в количестве 0,01–0,5 мол.%. Выращенные кристаллы CdI_2 принадлежат к политипу 4Н, CdBr_2 – к политипу 6R, что установлено методами

рентгеноструктурного анализа. Спектры поглощения и люминесценции представлены на рис. I.

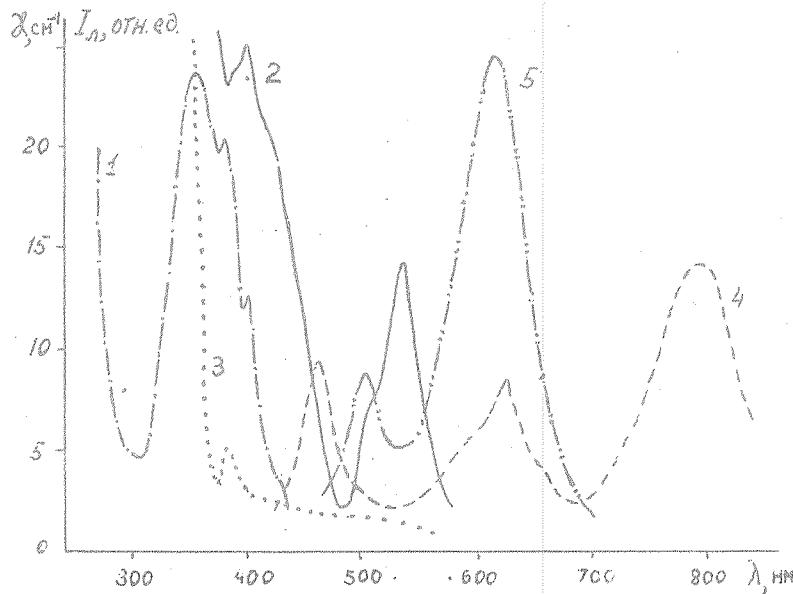


Рис. I. Спектры поглощения $\text{CdBr}_2\text{-Eu}$ (1), $\text{CdI}_2\text{-Eu}$ (2), CdI_2 (3) и люминесценции $\text{CdBr}_2\text{-Eu}$ (4), $\text{CdI}_2\text{-Eu}$ (5) при $T = 80$ К

В спектрах поглощения $\text{CdBr}_2\text{-Eu}$ наблюдается широкая полоса $\lambda_{\max} = 352$ нм /3/. Коэффициент поглощения в ее максимуме, определенный методом двух толщин, составляет $18\text{--}20 \text{ см}^{-1}$ при концентрации примеси $N = 1,2 \cdot 10^{19} \text{ см}^{-3}$. Сила осциллятора $f = 8,1 \cdot 10^{-4}$ оценивалась по формуле Смакулы-Декстера /4/. Такое значение f и наличие ЭПР Eu^{2+} в этом кристалле /5/ позволяют предположить, что данная полоса в спектре $\text{CdBr}_2\text{-Eu}$ связана с межконфигурационными переходами $4f^7 \rightarrow 4f^6 5d$ в ионах Eu^{2+} .

Аналогичная полоса в спектрах поглощения $\text{CdI}_2\text{-Eu}$ наблюдается в области 370–400 нм, совпадающей с областью края собственного поглощения и в полосе 334 нм, характерной для чистых кристаллов /6/. В отличие от $\text{CdBr}_2\text{-Eu}$ в спектрах поглощения кристаллов $\text{CdI}_2\text{-Eu}$ наблюдается еще одна интенсивная полоса

поглощения европия при 545 нм (с уступом в области 520 нм). Спектры ЭПР снимались на частоте 9420 МГц при температуре 77 и 300 К. Образцы ориентировались в резонаторе спектрометра по естественным плоскостям скола. Проведенные исследования показали, что образцы $\text{CdI}_2\text{-Eu}$ имеют анизотропный спектр ЭПР, характерный для иона $\text{Eu}^{2+}(^8S_{7/2})$. Однако, в отличие от европия в $\text{CdBr}_2\text{-Eu}$ /5/, этот ион в решетке $\text{CdI}_2\text{-Eu}$ образует несколько неэквивалентных парамагнитных центров с главной осью третьего (шестого) порядка, совпадающей с осью с кристалла. Наиболее интенсивен спектр типа I (рис. 2). В кристаллах с содержанием европия 0,1% интенсивность спектра типа II в 8–10 раз меньше. Кроме того, наблюдается еще более слабый спектр (типа III), который пока не исследован. Значительное анизотропное уширение всех линий ЭПР связано, по-видимому, с не строгой параллельностью атомных слоев сформированного кристалла.

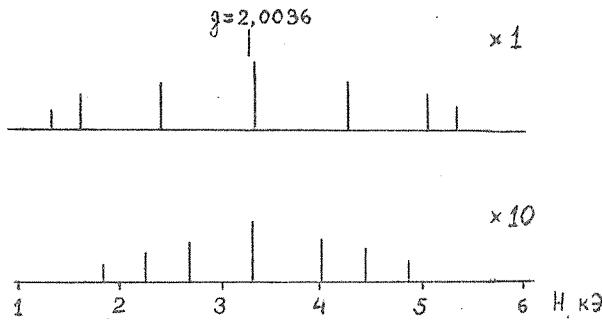


Рис. 2. Тонкая структура в спектре ЭПР центров Eu^{2+}I и Eu^{2+}II в кристалле $\text{CdI}_2\text{-Eu}$ при 77°C . Указаны положения середины групп линий сверхтонкой структуры из 12 компонент

Достаточно высокая симметричность полученных спектров ЭПР относительно центральной линии тонкой структуры позволила для приближенного описания использовать гамильтониан /7/

$$\mathcal{H} = g \beta \vec{H} \vec{s} + \frac{1}{3} b_2^0 \vec{o}_2^0 + \frac{1}{60} b_4^0 \vec{o}_4^0 + \frac{1}{1260} b_6^0 \vec{o}_6^0 + A \vec{s} \vec{i}.$$

Параметры гамильтонина, полученные из опыта, приведены в таблице (знак b_2^0 принят положительным)

Центр	Т-ра измер., К	g	b_2^0, ϑ	b_4^0, ϑ	b_6^0, ϑ	$^{151}\text{A}, \vartheta$	$^{153}\text{A}, \vartheta$
Eu^{2+} I	300	$1,994 \pm 0,001$	389 ± 3	-16 ± 2	$-1,6 \pm 1$	$26,5 \pm 1$	$II, 5 \pm 1$
"	77	$1,996 \pm 0,001$	434 ± 3	-18 ± 2	-2 ± 1	$26,5 \pm 1$	$II, 5 \pm 1$
Eu^{2+} II	77	$1,994 \pm 0,001$	249 ± 3	-6 ± 2	$3,5 \pm 1$	$33,2 \pm 1$	$II, 4 \pm 1$

Наличие нескольких типов парамагнитных центров Eu^{2+} в $\text{CdI}_2\text{-Eu}$ указывает на то, что европий внедряется в решетку в две различные позиции. Поскольку ионный радиус Eu^{2+} ($r_i = 1,20 \text{ \AA}$) не меньше, а даже превышает радиус иона Cd^{2+} ($r_i' = 0,97 \text{ \AA}$), ион европия в решетке CdI_2 и CdBr_2 занимает межузельные октаэдрические пустоты, замещая катион Cd^{2+} .

Спектр ЭПР типа I, как наиболее интенсивный, очевидно, принадлежит иону Eu^{2+} в решетке основного политипа 4H. Спектр типа II связан, по-видимому, с политипом 2H или нерегулярными ошибками наложения, присутствующими в кристаллах $\text{CdI}_2\text{-Eu}$ в небольших количествах. Наличие таких дефектов, дополнительных к основному политипу, приводит к образованию катионных позиций, отличающихся потенциалом кристаллического поля от исходных позиций в чистом политипе 4H, т.е. приводит к образованию парамагнитных примесных центров с различающимися параметрами.

Предположение о том, что центры типа II образованы европием в межсэндвичевых позициях в решетке, следует отвергнуть, поскольку, как показали наши опыты, в кристаллах $\text{CdBr}_2\text{-Eu}$ при такой же, и даже большей концентрации европия обнаруживаются только центры Eu^{2+} в катионных позициях.

Люминесценция кристаллов $\text{CdI}_2\text{-Eu}$ и $\text{CdBr}_2\text{-Eu}$ малоинтенсивна, поэтому для возбуждения использовался азотный лазер ЛГИ-21 ($\lambda = 337,1 \text{ нм}$, длительность импульса возбуждения — 8 нс, мощность 1,6 кВт). Время послесвещения определялось с помощью осциллографа С 7-8. В спектрах люминесценции $\text{CdBr}_2\text{-Eu}$ наблюдается полоса в области 455 нм [2]. При 80 К она имеет полуширину $0,14 \text{ эВ}$ и $\tau = 5,3 \cdot 10^{-6} \text{ с}$, слабо зависящее от температуры (рис. 3). Температурное тушение данной полосы хорошо описывает-

ся формулой Мотта с энергией активации $E_A = 0,12$ эВ, и ее можно приписать разрешенным дипольным переходам $\Gamma_8^+ - ^8S_{7/2}$ электронных конфигураций $4f^65d$ и $4f^7$ в центре Eu^{2+} . Ряд полос люминесценции в области 500–700 нм и полоса с максимумом при 770 нм ($\tau = 4 \cdot 10^{-6}$ с) также носят явно выраженный примесный характер, но детально не исследовались.

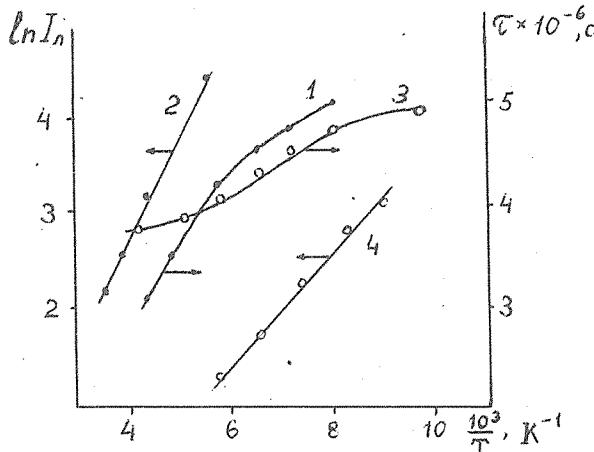


Рис. 3. Температурная зависимость времени затухания τ и интенсивности люминесценции I_L в полосе 455 нм в $\text{CdBr}_2\text{-Eu}$ (1,2) и в полосе 490 нм в $\text{CdI}_2\text{-Eu}$ (3,4) при возбуждении лазерным светом 337,1 нм

В спектре люминесценции $\text{CdI}_2\text{-Eu}$ наблюдаются две полосы при 490 и 540–580 нм, которые возбуждаются как в области собственного поглощения, так и в более длинноволновой области. Коротковолновая полоса неэлементарна, характеризуется $\tau = 5 \cdot 10^{-6}$ с, слабо зависящим от температуры, и может быть связана со свечением центров Eu^{2+} в несколько различающихся позициях в решетке.

Следует отметить, что при охлаждении интенсивность люминесценции центров Eu^{2+} в обоих кристаллах растет быстрее, чем измеренное τ . Это можно объяснить тем, что на исследуемые полосы накладывается свечение каких-то других центров с большим

т. Такие центры могут присутствовать, так как неактивированные кристаллы слабо люминесцируют приблизительно в тех же спектральных областях, что и активированные европием.

Авторы благодарны Н. Н. Григорьеву за обсуждение результатов работы.

Поступила в редакцию
17 апреля 1981 г.

Л и т е р а т у р а

1. Е. Е. Букке, Н. Н. Григорьев, М. В. Фок, Труды ФИАН, 79, 108 (1974).
2. Г. Е. Архангельский и др., в кн. "Вопросы изоморфизма и генезиса минеральных индивидов и комплексов". Часть 2, Элиста, Калмыцкий гос. ун-т, 1977 г., с. ЗII.
3. И. М. Болеста, А. Б. Лыкович, Х. У. Мартинес, Х Уральское совещание по спектроскопии. Спектроскопия твердого тела, тезисы докладов, 1976 г., с. 65, 69.
4. D. L. Dexter, Phys. Rev., 101, 48 (1956).
5. М. Д. Глинчук и др., Физика низких температур, 2, 1203 (1976).
6. Н. М. Болеста, Укр. физ. журнал, 21, 28 (1976).
7. P. B. Dorain, Phys. Rev., 120, 1190 (1960).